

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成28年6月23日(2016.6.23)

【公開番号】特開2015-122504(P2015-122504A)

【公開日】平成27年7月2日(2015.7.2)

【年通号数】公開・登録公報2015-042

【出願番号】特願2014-259265(P2014-259265)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/312 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/312 A

【誤訳訂正書】

【提出日】平成28年5月9日(2016.5.9)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 3 1

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 3 1】

未架橋の架橋性高分子は、典型的には 6 0 0 0 超、例えば 6 0 0 0 ~ 3 0 , 0 0 0、好ましくは 8 0 0 0 超、9 0 0 0 超または 1 0 , 0 0 0 超の重量平均分子量 M_w を有し、8 0 0 0 超 ~ 2 0 , 0 0 0 未満、9 0 0 0 ~ 1 8 , 0 0 0 および 1 0 , 0 0 0 ~ 1 5 , 0 0 0 が典型的である。好ましい分子量により、合成中の妥当な歩留りおよび低膨張性 (low swelling) / 使用の際にギャップ充填組成物に接触する溶剤、例えば下層反射防止膜 (BARC)、フォトレジスト、および現像液材料で使用される溶剤への高剥離抵抗性が可能となる。高膨張性 / 低剥離抵抗性は、上塗りしたフォトレジストのパターニング中にパターン崩壊を生じ得る。